

КТ8272

кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

Транзистор п-р-п кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе предназначен для использования в линейных усилителях, схемах преобразователей напряжения, ключевых схемах и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

Зарубежные прототипы

- КТ8272А - BD135
- КТ8272Б - BD137
- КТ8272В - BD139

Номер технических условий

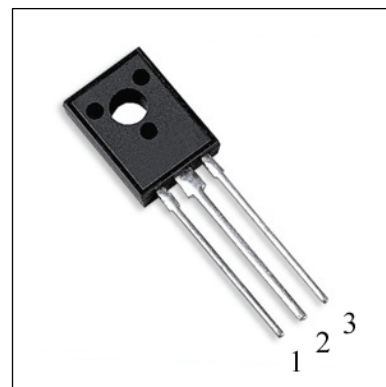
- АДБК. 432140. 094 ТУ

Особенности

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °С

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-27 (ТО-126)

**Назначение выводов**

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	Коллектор
№3	База

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ8272 при $T_{\text{окр. среды}} = + 25^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение колл-эмит КТ8272А КТ8272Б КТ8272В	* $U_{кэ0 гр.}$	В	$I_k=30\text{mA}, I_b=0$	45 60 80	
Обратный ток коллектора	$I_{кбо}$	мкА	$U_{кэ}=30\text{В}, I_b=0$		0,1
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мкА	$U_{эб}=5\text{В}, I_k=0$		10
Статический коэффициент передачи тока	* $h_{21э}$		$U_{кэ}=2\text{ В}, I_k=0,5\text{A}$ $U_{кэ}=2\text{ В}, I_k=5\text{ mA}$ $U_{кэ}=2\text{ В}, I_k=150\text{ mA}$	25 25 40	- - 250
Напряжение насыщ. коллектор-эмиттер	* $U_{кэ нас}$	В	$I_k=0,5\text{ A}, I_b=50\text{ mA}$		0,5
Напряжение насыщения база-эмиттер	* $U_{бэ нас}$	В	$I_k=0,5\text{ A}, I_b=50\text{ mA}$		1,0

* - $t_i \leq 300\text{мкс}, Q > 50$

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ8272

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-база ($I_b = 0$) КТ8272А КТ8272Б КТ8272В	$U_{кб max}$	В	45 60 80
Напряжение коллектор-эмиттер ($I_b = 0$) КТ8272А КТ8272Б КТ8272В	$U_{кэ max}$	В	45 60 80
Напряжение эмиттер-база	$U_{эб max}$	В	5
Постоянный ток коллектора	$I_k max$	А	1,5
Импульсный ток коллектора	$I_{ки max}$	А	3
Максимально допустимый постоянный ток базы	$I_b max$	А	0,5
Рассеиваемая мощность коллектора: при $T_{корп} \leq 25^{\circ}\text{C}$ при $T_{ср} \leq 25^{\circ}\text{C}$	$P_k max$	Вт	10 1,0
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_{тпер-корп}$	$^{\circ}\text{C} / \text{Вт}$	12,5
Тепловое сопротивление переход-среда	$R_{тпер-ср}$		125
Температура перехода	$T_{пер}$	$^{\circ}\text{C}$	150



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>